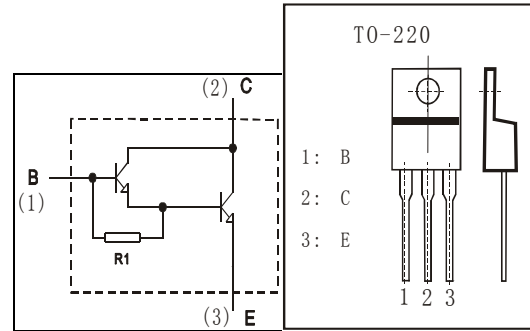


## 达林顿管—TSE798

### 1、概述与特点

TSE798 是硅外延、单片集成达林顿结构的 NPN 型功率晶体管。应用于线性 and 开关电路中的功率器件。

封装形式：TO-220



### 2、电性能

极限参数(Tamb=25℃)

参数名称		符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压		$V_{CBO}$	600	V
集电极-发射极击穿电压		$V_{CEO}$	300	V
发射极-基极击穿电压		$V_{EBO}$	5	V
集电极电流		$I_C$	6	A
基极电流		$I_B$	1	A
耗散功率	$T_c=25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	65	W
	$T_a=25^\circ\text{C}$		2	W
贮存温度		$T_{stg}$	-40 ~ 125	℃
结温		$T_j$	125	℃

电参数 (Tamb=25℃)

参数名称	符号	单位	规范值			测试条件
			最小	典型	最大	
集电极-发射截止电流	$I_{CEO}$	mA			0.5	$V_{CE}=300\text{V}, I_B=0$
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	mA			0.5	$V_{CB}=600\text{V}, I_E=0$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	mA			0.5	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$
集电极-发射极击穿电压	$V_{CEO(sus)}$	V	300			$I_C = 500\text{mA}, L=40\text{mH}$
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)*}$	V			2	$I_C = 4\text{A}, I_B = 40\text{mA}$
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)*}$	V			2.5	$I_C = 4\text{A}, I_B = 40\text{mA}$
直流增益	$h_{FE*}$		1500			$I_C = 2\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}$
			200			$I_C = 4\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}$